Requested document: JP1081931 click here to view the pdf document

NONLINEAR OPTICAL MATERIAL AND NONLINEAR OPTICAL **ELEMENT USING SAID MATERIAL**

Patent Number:

JP1081931

Publication date:

1989-03-28

Inventor(s):

MATSUOKA MASARU; others: 05

Applicant(s):

SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

Requested Patent:

☐ JP1081931

Application Number: JP19870240313 19870924

Priority Number(s): IPC Classification:

G02F1/35; G02B6/00

EC Classification:

Equivalents:

JP2539850B2

Abstract

PURPOSE:To improve a nonlinear optical effect by incorporating a specific compd. having an electronattracting atom or electron-attracting group, electron-domating group and electron system into the titled material.

CONSTITUTION: This material contains at least the compd. expressed by formula I. In formula I, R<1> and R<2> are the electron-attracting atom or electron-attracting group; R<3> and R<4> are a straight chain or branched chain alkyl group or alkoxy group; X is a substituent having a hydrogen atom which permits hydrogen bonding. The biphenyl compd. expressed by formula I is the intramolecular charge transfer type compd. in which the benzene skeleton having the electron- attracting atom or electronattracting group is bonded to the benzene skeleton substd. with the substituent exhibiting an electrondomating property and having the hydrogen atom permitting hydrogen bonding and the electrons are largely transferred by electron transition and, therefore, the nonlinear optical constant betaat a molecular level is large. The nonlinear optical effect is thereby improved.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

BEST AVAILABLE COPY

9日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-81931

@Int_Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和64年(1989)3月28日

G 02 F 1/35 G 02 B 6/00 3 0 5

7348-2H E-7370-2H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全11頁

図発明の名称 非

非線形光学材料とそれを用いた非線形光学素子

②特 願 昭62-240313

②出 願 昭62(1987)9月24日

⑫発 明 者 松 岡

賢 奈良県天理市遠田町392

⑫発 明 者 北 尾

悌 次 郎

大阪府富田林市青葉丘23

の発明者 上宮

崇文

大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株

式会社大阪製作所内

⑪発 明 者 清 水

洋

大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株

式会社大阪製作所内

⑩発明者 上西 直太

大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株

式会社大阪製作所内

外1名

⑪出 顋 人 住友電気工業株式会社

大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

迎代 理 人 弁理士 亀井 弘勝

最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称

非線形光学材料と

それを用いた非線形光学素子

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 下記一般式(I)で表される化合物を少なくとも含有することを特徴とする非線形光学材料。

 一般式(I)で表される化合物において、 R! およびR2 が、ニトロ基、シアノ基、 シアノアルキル基、シアノアルコキシカ

- 3. 一般式(I)で表される化合物において、 R³ およびR⁴ が、直鎖状または分岐鎖 状低級アルキル甚または低級アルコキシ 基である上記特許請求の範囲第1項記載 の非線形光学材料。
- 4. 一般式(I)で表される化合物において、 X が、ヒドロキシ茲、メルカプト茲、ア ミノ茲、イミノ茲、カルボキシ茲、カル

バモイル茲、ヒドロキシアルキル茲、ヒドロキシアミノ茲およびヒドロキシイミノ茲からなる群から選ばれた置換茲である上記特許請求の範囲第 1 項記載の非線形光学材料。

- 5. 一般式(I)で表される化合物において、 R!およびR2か、ペンゼン環の2-位 および4-位に置換している上記特許請 求の範囲第1項または第2項記載の非線 形光学材料。
- 6. 一般式(I)で表される化合物において、 R 3 および R 4 が、ベンゼン環の 3 一位 および 5 一位に置換している上記特許請 次の範囲第 1 項または第 3 項記載の非線 形光学材料。
- 7. 一般式(I)で表される化合物が、3.5
 -ジメチル-2 . 4 . ジニトロー1.
 1 . ピフェニル-4 オールである上記特許請求の範囲第1項記載の非線形光学材料。

はアルキル基またはアルコキシ基、Xは水素結合可能な水素原子を有する置換基を示す)

- 11. 非線形光学案子が、非線形光学材料からなるコアと、該コアを被覆する非線形光学効果を示さない媒質からなるクラッドとで構成されている上記特許請求の範囲第10項記載の非線形光学案子。
- 12. 非線形光学案子が、非線形光学効果を示さない媒質からなる透板と、該基板に形成された非線形光学材料からなる光導液部とで構成されている上記特許謝求の範囲第10項記載の非線形光学案子。
- 13. 非線形光学案子が、非線形光学効果を示さない媒質からなる基板と、非線形光学効果を示さない媒質からなる層と、上記基板と層との間に形成された非線形光学材料からなる光導波部とで構成されている上記特許請求の範囲第10項記載の非線形光学案子。

特開昭64-81931(2)

- 8. 一般式(I)で表される化合物が、3.5 - ジー tort - ブチルー2 . 4 . - ジニ トロー1.1 . - ピフェニルー4 - オー ルである上記特許請求の範囲第1項記載 の非線形光学材料。
- 9. 一般式(I)で表される化合物の単一成分 結晶からなる上記特許請求の範囲第1項、 第7項および第8項のいずれかに記載の 非線形光学材料。
- 10. 光導波部を有する非線形光学案子であって、上記光導波部が下記一般式(I)で表される化合物を少なくとも含有する非線形光学材料で構成されていることを特徴とする非線形光学案子。

$$R^{1} \xrightarrow{R^{2}} R^{3} \qquad (1)$$

(式中、R 1 およびR 2 は電子吸引性原子または電子吸引性器、R 3 およびR 4

- 14. 非線形光学案子が、非線形光学効果を示さない媒質からなる基板と、設基板に形成された非線形光学材料からなる光導波部と、上記光導波部に電界を作用させる電極とで構成されている上記特許請求の範囲第10項記載の非線形光学素子。
- 3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は非線形光学材料とそれを用いた非線形光学素子に関し、より詳細には、オブトエレクトロニクス分野で好適に使用されるピフェニル系化合物を少なくとも含有する非線形光学材料とそれを用いた非線形光学素子に関する。

く従来技術及び発明が解決しようとする問題点> 非線形光学効果は、媒質に光が入射したとき、 その光の電場の2乗以上の高次の項に比例する分 極が生じる現象であり、レーザ光等の強電界下で は非線形光学効果が顕著に現れる。この非線形光 学効果により、第2高調波発生、カー効果、光双 安定などが可能となり、特に光の電場の2乗に比

特開昭64-81931(3)

例して起る 2 次非線形光学効果は光波長変換業子、 光変調案子等の非線形光学素子としてオプトエレ クトロニクス分野の発展を約束する素子への応用 が可能であるため多くの注目を集めている。

近年になって、無機系材料に比べて有機系材料の方がはるかに高い非線形光学特性を有することが見出だされ、例えば、2-メチル-4-ニトロ

ことを目的とする。

< 問題点を解決するための手段および作用 > 第 1 の発明の非線形光学材料は、下記一般式(I)で表される化合物を少なくとも含有することを特徴とする。

$$R^{2} \longrightarrow R^{3}$$
 (I)

(武中、R1 およびR2 は電子吸引性原子または電子吸引性基、R3 およびR4 は直鎖状または分岐鎖状アルキル甚またはアルコキシ基、Xは水器結合可能な水素原子を育する置換基を示す)

有機非線形光学材料において、非線形光学定数 Bを火きくするには、光の電場により分極が生する際に、分子内の電子移動がスムーズに進行する ことが必要であり、また2次の非線形光学材料に ついては、分子配列が対称中心をもたないような 材料でなければならないとされるが、第1の発明 は上記の構成よりなり、一般式(])で表されるピフ アニリン (MNA) に代表されるように、 π電子 系を有すると共に分子内に電子供与性基と電子吸 引性基とを有し、極めて大きい非線形光学定数を 有する材料が注目されている。しかし、2次の非 線形光学効果を得るためには、結晶構造が反転対 称中心を持たないことが必要であり、さらに結晶 内の分子が一方向に並んだ構造が理想的であるが、 2次の非線形光学定数 В (以下、非線形光学定数 Bと称する)が分子状態でMNAに比べて大きい 化合物、即ち、より大きい永久双極子モーメント またより大きいπ電子系を有する化合物の結晶機 造を制御することは極めて困難であり、今まで M NAより高い2次非線形光学効果を有する有機系 化合物の報告例はほとんどなく、従って、MNA より高効率の非線形光学材料および非線形光学素 子は知られていない。

<目的>

本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、高い非線形光学効果を有する有機系非線形光学材料とそれを用いた非線形光学券子を提供する

エニル系化合物は、電子吸引性原子または電子吸引性基を有するペンゼン骨格が、電子供与性をでするので、素原子を有する電池を設定にはなってであるので、おのサークの非線を有するのであるく、であるので、であるので、であるので、であるので、であるので、であるのであるが、できるとは、ないでものできる。 には は に は に は に は に な に な に に に な に に に な に に に な に に と か で き る に と か で き る に と か で き る に と か に は に に な で き る に と か に は に に な に に な に に な に に な に に な に に な に に な に な に に な に な に に な な に な な な に な に な な に な な に な な に な な に

なお、一般式(I)で表されるピフェニル系化合物において、RIおよびR2が、ニトロ基、シアノルカルボニルカルボニルを、シアノアルコキシカルボニルルケニル基、シアノアルコキシカルボニルをでしていてもよいアルカンスルホニル基、カルボキシ基、エステル化されたスルホ基、アシル基、温度基を有していてもよいカルバモイル基、温度基を有していてもよいカルバモイル基、温度基を有していてもよいカルバモイル基、温度基を有していてもよいカルバモイル基、

特開昭64-81931 (4)

特に、R1 およびR2 が、ベンゼン環の2-位 および4-位に置換し、R3 およびR4 が、ベン ゼン環の3-位および5-位に置換している化合 物は、さらに大きな非線形光学定数 B を示すと共 に、結晶構造の制御が容易である。

さらには、一般式(I)で表される化合物が、3, 5-ジメチルー2^{*}, 4^{*}-ジニトロー1, 1^{*} --ピフェニルー4-オールや、3, 5-ジーtert

が大きな 2 次の非線形光学素子が得られ、光強度の弱いレーザ光でも高強度の第 2 高調波を分離でき、また少ない電圧変化でも電気光学効果を効率よく発現できる。

以下に、第1の発明を詳細に説明する。

上記一般式(1)で表される化合物において、RIおよびR? は、電子吸引性原子または電子吸引性 原子または電子吸引性 原子または電子吸引性 なとしては、水素原子: ニトロ な; シアノブロピルボニンク ファイー 2 ー シャー・ 3 ー シャー・ 3 ー シャー・ 4 シャルボニル ステル、 3 ー シャノー 3 ー ブロボキシカルボニルエチル、 3 ー シアノー 3 ー ブロボキシカルボニルエチル、 3 ー シアノー 3 ー ブロ・ 4 シカルボニルブロピル、 3 ー シアノー 3 ー ブロポキシカルボニルブロピル、 3 ー シアノー 3 ー ブロポキシカルボニルブロピル、 3 ー シアノー 3 ー ブロピル 、 3 ー シャノー 3 ー ブロピル ・ 4 ・ シャルボニルブロピル ・ 3 ー シャノー 3 ー ブロピル ・ 3 ー シャノー 3 ー ブロピル ・ 4 ・ シャルボニルブロピル ・ 3 ー シャノー 3 ー ブロピル ・ 5 ・ シャノー 5 ・ シャ

ープチルー2 、4 ・ ージニトロー1、1 ・ ービフェニルー4 ーオールであるものは、ヒドロキシル基に基づく水素結合と、アルキル基のかさばりとにより結晶構造が制御されていると共に、ニトロ基が電子吸引性を示し、ヒドロキシ基およびアルキル基が電子供与性を示すので、電子遷移に伴なって電子が大きく移動し、非線形光学定数 B が大きく、結晶状態でも顕著な非線形光学効果をもたらす。

また、一般式([])で表される化合物の単一成分結 品は、大きな非線形光学効果を発現する。

第2の発明の非線形光学案子は、光導波部を有する非線形光学案子であって、上記光導波部が、上記一般式(I)で表される化合物を少なくとも含有する非線形光学材料で構成されていることを特徴とする。

上記構成の非線形光学素子によれば、光導波部が、大きな非線形光学定数を示す上記一般式(I)で表される化合物を少なくとも含有する上記非線形光学材料で構成されているため、非線形光学効果

トキシカルポニルプロピル、4-シアノ-4-エ トキシカルポニルプチルなどのシアノアルコキシ カルポニルアルキル茲;2-シアノ-2-メトキ シカルポニルピニル、2-シアノー2-エトキシ カルポニルピニル、2-シアノ-2-プロポキシ カルボニルピニル、2-シアノ-2-ブトキシカ ルポニルビニル、2-シアノ-1-メチル-2-メトキシカルボニルピニル、2-シアノ-1-メ チルー2-エトキシカルポニルピニル、2-シア ノー1 - メチルー2 - プロポキシカルポニルピニ ル、2-シアノ-1-メチル-2-プトキシカル ポニルビニル、3-シアノ-3-メトキシカルボ ニルアリルなどのシアノアルコキシカルポニルア ルケニル甚;フッ素、塩素、臭素、ヨウ素などの ハロゲン原子;メタンスルホニル、エタンスルホ ニル、プロパンスルホニル、ブタンスルホニル、 トリフルオロメタンスルホニル、2, 2, 2-ト リフルオロエタンスルホニルなどのハロゲン原子 を有していてもよいアルカンスルホニル基;スル ホ尪;メトキシスルホニル、エトキシスルホニル、

特開昭64-81931 (5)

プロポキシスルホニル、イソプロポキシスルホニ ル、プトキシスルホニル、tert-プトキシスルホ ニル、ペンチルオキシスルホニル、ヘキシルオキ シスルホニル、オクチルオキシスルホニルなどの アルコキシスルホニル、フェノキシスルホニル、 p - シアノフェノキシスルホニルなどの間換其を 有していてもよいフェノキシスルホニル等のエス テル化されたスルホ盐;カルポキシ盐;メトキシ カルポニル、エトキシカルポニル、プロポキシカ ルポニル、イソプロポキシカルポニル、プトキシ カルポニル、イソプトキシカルポニル、tert-プ トキシカルボニル、ヘキシルオキシカルボニル、 オクチルオキシカルポニルなどのアルコキシカル ポニル基、フェノキシカルポニル、p-ニトロフ ェノキシカルボニルなどの置換基を有していても よいアリールオキシカルポニル、ベンジルオキシ カルボニル、ベンズヒドリルオキシカルボニルな どのアラルキルオキシカルポニル等のエステル化 されたカルポキシ茲;ホルミル、アセチル、プロ ピオニル、ブチリル、ヘキサノイル、ベンソイル

などのアシル甚;カルパモイル、メチルカルバモイル、ジメチルカルバモイル、エチルカルバモイル、フェニルカルバモイル、プロピルカルバモイルなどの置換 悲を有していてもよいカルバモイルなど、スルファモイル、ストロスルファモイル、ベンジルスルファモイル、などの置換 甚を有していてもよいスルファモイルなどの置換 甚を有していてもよいスルファモイルなどの置換 甚を有していてしよ;チオカルボキシ茲はどが例示できる。

上記電子吸引性原子または電子吸引性基のうち、
ニトロ甚、シアノ甚、シアノアルキル基、シアノアルキル基、シアノアカルボニルアルキルを、シアノアカルボニルアルケニル甚、ハロゲン原子を有していてもよいカルボキシ基、エステル化されたカルボキシ基、アシル基、置換基を有していてもよいスルファモイルをからなる群から選ばれた電子吸引性原子また

は世子吸引性甚、特に電子吸引性が大きなニトロ 茲、シアノ甚、シアノアルコキシカルボニルアル ケニル基、フッ素原子、カルボキシ基、エステル 化されたカルボキシ基、アシル基、中でも、ニト ロ基が好ましい。

また、一般式(I)で表される化合物において、R 1 およびR 2 は、ベンゼン環の適宜の位置に置換していてもよいが、電子吸引性を高め、非線形光学定数 8 を大きくするため、ベンゼン環の 2 - 位および 4 - 位に置換しているものが好ましい。

また、一般式(!)で表される化合物において、R3 およびR4 は直鎖状または分岐鎖状アルキル基またはアルコキシ甚を示し、該アルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、tertーブチル、ペンチル、ヘキシルオキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソプトキシ、tertーブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、オクチルオキシ基などが例示さ

れる。上記直鎖状または分岐鎖状アルキル基およびアルコキシ基のうち、炭素数1~6の直鎖状または分岐鎖状低級アルキル基および低級アルコキシ基、特に非線形光学定数8の大きなメチル基、tertープチル基が好ましい。

なお、上記置換基R3 およびR4 は、ベンゼン環の適宜の位置に置換していてもよいが、非線形光学定数 β を大きくするため、ベンゼン環の 3 ー位および 5 ー位に置換しているものが好ましい。

また、一般式(I)で表される化合物において、 X は、水素結合可能な水素原子を有する選換基を示 す。上記水素結合可能な水素原子を有する選換基 としては、ヒドロキシ基;メルカプト基;アミノ 基;メチルアミノ、エチルアミノ、プロピルアミ ノ、イソプロピルアミノ、ブチルアミノ、ヘキン ルアミノ、オクチルアミノなどのモノアルキルア ミノ基;ベンジルアミノなどのモノアリールア ミノ基;フェニルアミノなどのモノアリールアミ ノ 法:イミノ基;カルボキシ基;カルバモイル基; メチロール、 2 ーヒドロキシエチル、 3 ーヒドロ キシプロピルなどのヒドロキシアルキル茲:ヒドロキシアミノ茲およびヒドロキシイミノ茲などが 例示される。上記水素結合可能な水素原子を有す る置換茲のうち、ヒドロキシ茲、メルカプト茲、 アミノ茲、イミノ茲、カルボキシ茲、カルバモイ ル茲、ヒドロキシアルキル茲、ヒドロキシアミノ 茲およびヒドロキシイミノ茲、中でも、水素結合 能が大きなヒドロキシ茲が好ましい。

としてはこの反応に悪影響を及ぼさない溶媒であ ればいずれの溶媒も使用でき、例えば、n-ヘキ サン、n-オクタン、シクロヘキサン等の脂肪族 または脂環族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、 キシレン等の芳香族炭化水紫類、メタノール、エ タノール、プロパノール等のアルコール類、アセ トン、メチルエチルケトン等のケトン類、ジエチ ルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等 のエーテル類、アセトニトリル、ジメチルホルム アミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルリ ン酸トリアミドなどが例示される。該反応は、通 常、加温ないし選流下にて行われ、反応は約30 分ないし48時間程度で終了する。反応終了後、 反応混合物を濃縮し、再結晶、溶媒抽出、カラム クロマトグラフィー等の慣用の手段で容易に分離 桁製することができる。

前記一般式(I)で表される化合物を少なくとも含有する非線形光学材料は、一般式(I)で表される化合物の単一成分結晶であってもよく、一般式(I)で表される化合物と、他の非線形光学材料や液晶性

前記一般式(I)で表されるピフェニル系化合物は、例えば、下記一般式(II)で表される化合物と下記一般式(II)で表される化合物と下記一 般式回で表される化合物との反応により製造する ことができる。

$$\mathbb{R}^1$$
 \mathbb{R}^2
 \mathbb{R}^2
 \mathbb{R}^3

(式中、R¹、R²、R³、R⁴およびXは前記 に同じ。)

上記一般式(I)で表される化合物と一般式(II)で表される化合物とから前記一般式(I)で表される化合物を得る反応は、通常有機溶媒中で行われ、溶媒

高分子どの混合物からなる混合物結晶または混合物固体であっても記して有いながながない。前記一般子をおこれでするのでは、おこれですながない。前記一般子をおいて、ないないでするのでは、おいては、おいては、おいのでは、おいのでは、おいのでは、おいのできる。は、学効果の大きな非線形材料とすることができる。

上記他の非線形光学材料としては、極々の有機非線形光学材料が用いられるが、好ましくは非線形光学定数の大きい材料、例えば、2次の非線形光学定数 B が 5 × 10⁻³⁰ esu 以上の化合物が用いられる。このような有機非線形光学材料としては、分子内に電子吸引性基と電子供与性基を育する化合物、例えば、前記 M N A の他、1 - メトキシー4 - (4 - ニトロベンジリデンアミノ)ベンゼン、1 - メチルー4 - (4 - ニトロベンジリデンアミノ)ベンゼン、1 - エチルー4 - (4 - ニトロベ

特開昭64-81931(ア)

ンジリデンアミノ) ベンゼン、1-プロピル-4 - (4-ニトロペンジリデンアミノ) ベンゼン、 1-ブチル-4- (4-ニトロペンジリデンアミ ノ) ベンゼン、1~(4-ニトロベンジリデンア ミノ) - 4 - ヘキシルベンゼン、1 - (4 - ニト ロベンジリデンアミノ) -4-オクチルベンゼン、 1-エチル-4- (4-シアノベンジリデンアミ ノ) ベンゼン等のシッフ塩基型化合物:1-メチ ルアミノアントラキノン、2-メチルアミノアン トラキノン、1,4-ジアミノ-6~エトキシカ ルポニルアントラキノン、1,4-ジアミノ-2 - (1-ピロリジニル)アントラキノン等のアン トラキノン誘導体:エチル 1.3-ジチオール - 2 - イリデンシアノアセテート、エチル 4 -メチルー1、 3 - ジチオール - 2 - イリデンシア ノアセテート等のジチオール誘導体; β, βージ シアノー4ーメトキシスチレン、β、βージシア ノー4ーメチルスチレン等のスチレン誘導体: 2 - プロモー4 - ニトローN, N - ジメチルアニリ

スチルベン:2-エチルアミノ-1、3、4-チアジアソールなどが例示される。前記一般式(I)で表される化合物と上記の有機非線形光学材料との混合比は、所望する光学特性、化合物の物性(例えば、融点、溶解度、 ス max など)等により適宜選択できる。

ールなどの極性溶媒でもよく、アセトニトリル、

酢酸エチル、ジエチルエーテル、テトラヒドロフ

ランなどの極性溶媒、ベンゼン、トルエン、シク

ロヘキサンなどの無極性または極性の小さな溶媒

であってもよい。なお、この際、必要により、不

所災窯を有する溶媒、例えば、(R) - 2 - ブタ

ノール等の不斉炭素を有する溶媒より結晶を得て
もよい。

また、上記液晶性高分子としては、例鎖にメリーゲン弦を有する側鎖型液晶性高分子、側鎖型中キリアクリレート系液晶合分子を側鎖型の中央の混合物の分子をの混合物の分子をのかって、前記の一般式([])で表される化合物の分子を列を制御するに合物と表のまた、前記の一般式([])で表される化合物と液晶性高分子との混合物を溶をさせたは、次に冷却して液晶状態とし、次いで光場または、

磁場を印加し、その状態で冷却し間化させること

により得られる。電場または磁場の印加により液晶性高分子が配向した状態で固化するので、一般式(I)で表される化得ることができる。上記の一般式(I)で表される化得ると被晶性を分子に記の一般である(I)で表される化の混合性をとり得るものには特に限定される他の表もの化はであるが、一般式(I)で表もの化なである。とのでは特に限定される液晶性高分子の性状である。とのではいるでは、通常のとはでで表される。

上記のように、前記一般式([])で表されるピフェニル系化合物を少なくとも含有する非線形光学材料は、非線形光学定数度が大きく、顕著な非線形光学効果を有する。従って、オプトエレクトロニクス分野で使用される非線形光学素子用材料、例えば、光波長変換案子用材料や、位相変調案子、緩縮変調素子、パルス変調案子、優光波面変調素子等の光変調案子用材料として好

- 適である。また、上記非線形光学材料は、一般式(I)で表される化合物の結晶そのものを光波接換素子として用いることが可能であるが、非線線形光学材料を光導波路とする導波路型光波接案子としてもよい [J. Zyss. J. Molecular Electronics 1. 25 (1985) など参照]。 導放路型光波是変換案子とすることにより、 導波路型光波 見近 強素子とすることにより、 導放 路内に光を閉じ込めるので、 光パワー密度が大きくので高効率化を 図ることができ、 さらにモード分散を利用した位相整合も可能である。

<実施例>

以下に、実施例を示す添附図面に基づいて、上記第1の発明の非線形光学材料を用いた非線形光学者料を用いた非線形光学素子について詳細に説明する。

第1図は本発明の光波長変換素子の一実施例であり、第2高調波発生素子としての光ファイバー型光波長変換素子の概略図を示し、一般式(I)で表される化合物を少なくとも含有する非線形光学材料(以下、非線形媒質と称する)からなるコア(1)

ブ暦 (33)との間に非線形媒質からなる光導波部 (31)が形成されいる。上記の光波長変換素子は、第1 図に示される光波長変換素子と同様にして使用される。

また、光変調素子としても従来から用いられて いる形態のデバイスとすることができる。第4図 は、その一例として、位相変調案子として、機型 動作の光導波路型光変調素子の概略図を示し、等 方性媒質よりなる基板(42)中に、非線形媒質から なる導波部(41)が設けられていると共に、該導波 部(41)を介して2つの電極(43)が長さ方向に沿っ て対向する位置に設けられており、該電極(43)間 に甩圧を印加することにより進界が形成される。 上記素子において、導波部(41)の長さ方向の一端 から入射された光が導波部(41)を通過し他端面か ら出射される際、導波部(41)を構成する非線形媒 質の屈折率が変化すると出射される光の位相も変 化する。非線形媒質の屈折率は印加電圧により変 化するので、電極(43)間の印加電圧を変化させる ことにより、出射光の位相変調を行なうことがで が、ガラス等の2次の非線形光学効果を示さない 数質(以下、等方性数質と称する)からなるクラッド(2)で被型された構造を有し、同図線は第2高額 線は外が これた光の基本波を、二点鎖線は第2高額波を示す。レーザ光等の光はレンズ で (1)に入射される。コア(1)を形成する非線形 数質は大きの 出対される となり出対される。

また第2図および第3図は、それぞれ光波長変換案子の他の実施例を示す概略図であり、図面中、一点鎖線および二点鎖線はそれぞれ第1図と同様な意味を示す。

第2図に示される光波長変換業子では、 等方性 媒質からなる基板 (22)上に非線形媒質からなる光 導波部 (21)が形成されており、また第3図に示さ れる光波長変換素子においては、 等方性媒質から なる基板 (32)と、同じく等方性媒質からなるトッ

きる。

上記第1図から第4図に示される光波長変換素 子において、コア(1)および光導波部(21)(31)(41) の形成は、例えば、非線形媒質原料を、それぞれ 等方性媒質からなるキャピラリー巾、等方性媒質 からなる導波路茲板上、または等方性媒質からな る導波路拡展間で、加熱溶融後、ゆっくりと冷却 させて結晶を折出させる方法、基板上に真空落着 法、商周波スパッタリング法等によって結品を折 出させる方法などにより行われ、また、適当な有 機溶媒に非線形媒質原料を溶解させた溶液から、 上記キャピラリー中、基板上または基板間に結晶 を析出させる方法によってもよい。さらに、場合 によっては、キャピラリー中、基板上または基板 間で非線形媒質との接触界面となるべき部分を配 向処理材で処理した後、非線形媒質を折出、結晶 成長させ光波長変換業子などを形成してもよい。 配向処理材としては、無機塩および有機塩(例え ば、臭化ヘキサデシルトリメチルアンモニウムな ど)、適当な高分子(例えば、ポリアミドなど)

特開昭64-81931 (9)

* からなる薄膜、金属錯体、金属薄膜(例えば、斜 め蒸着した金薄膜など)等が例示される。

なお、本発明の非線形光学素子は上記実施例に限定されるものではなく、光変調素子として踏型 振磁変調素子でもよく、また結晶などの非線形媒質 自体に直接電圧を印加する形態とすること媒質の 対称性、結晶軸の方向等により、位相変調を動物 よく行なうための電界印加方向変更するのがよい。 以下、具体例に基づいて本発明をより詳細に説

具体例1

叨する。

ジメチルスルホキシド40 取に、粉末状の水酸化ナトリウム1.2g(30ミリモル)、2.6 ージーtertーブチルフェノール4.1g(20ミリモル) およびmージニトロベンゼン5.0g (30ミリモル)を添加し、80℃の温度で2時間似作する。反応終了後、反応混合物を1N塩酸

(C. P. Stahly, J. Org. Chem. <u>50.</u> 3081 (1985)参照)

得られた結晶に、波長1.064 µmのNd:YAGレーザ光を照射したところ、第2高調波である波長0.532 µmの光が観測された。

具体例2

上記具体例 1 の 2 、 6 ージー tertーブチルフェ ノールに代えて、 2 、 6 ージメチルフェノールを 用い、上記具体例 1 と同様にして、 3 、 5 ージメ チルー 2 ~ 、 4 ~ ージニトロー 1 、 1 ~ ーピフェ ニルー 4 ーオール 2 、 8 g(収率 4 9 %)を得る。 融点: 1 8 2 ~ 1 8 3 ℃

¹ H - N M R (C D C £ 3) δ:

2. 28 (s, 6 H), 4. 90 (s, 1 H), 6. 98 (s, 2 H), 7. 61 (d, 1 H, J = 9 H z), 8. 43 (dd, 1 H, J = 2 H z, 9 H z), 8. 65 (d, 1 H,

J = 2 H z)
I R (K B r) :

3400.1540.1360cm⁻¹

水溶液 4 0 0 型に注ぎ、エチルエーテル 4 0 0 型で 3 回抽出する。抽出液を乾燥剂で乾燥し、濃縮した後、カラムクロマトグラフィーにより分離し、n - ヘキサンを用いて再結品することにより、目的物である 3 、5 - ジーtert - ブチルー 2 ~ 、4 ~ - ジニトロー 1 、1 ~ - ピフェニルー 4 - オール5 、1 g (収率 6 9 %)を得る。

融点:170~171℃

¹ H - N M R (C D C 1 3) δ:

1.47 (s, 18H), 5.52 (s,

1 H) 、7. 20 (s, 2 H) 、7. 70 (d, 1 H, J = 9 Hz) 、8. 41 (dd,

 $1 H \ J = 2 H z$

IR (KBr):

3600, 2980, 1545, 1445, 1356, 1245 ag ⁻¹

マススペクトル (70 e V) m / e (相対強度): 372 (M⁺, 6)、357 (19)、52 (100)、41 (36)

マススペクトル (70 e V) m/e (相対強度): 315 (M⁺, 9)、73 (100)、45 (24)

得られた結晶に、波長 1 . 0 6 4 µ の N d : Y A G レーザ光を照射したところ、第 2 高調波である波長 0 . 5 3 2 µ の光が観測された。

具体例3

具体例1で得た結晶を加熱溶融した後、ガラスキャピラリー(内径5~10 mm、外径0.5~1 mm、投さ2~3 cm)中に、毛細管現象を利用して注入した後、ブリッジマン炉内で結品を成長させ、光波長変換素子を作製した。この素子の一端面から、波長1.064 mmのNd:YAGレーザ光を照射したところ、他端面から波長0.532 mの第2高調波の発生が観測された。

具体例4

具体例2で得た結晶を加熱溶融した後、ガラスキャピラリー(内径5~10m、外径0.5~1m、 及さ2~3cm)中に、毛細管現象を利用して注入した後、ブリッジマン炉内で結品を成長させ、

特開昭 64-81931 (10)

* 光波長変換案子を作製した。この素子の一端面から、波長1.064μのNd:YAGレーザ光を 照射したところ、他端面から波長0.532μの 第2高調波の発生が観測された。

<発明の効果>

以上のように、第1の発明の非線形光学材料によれば、前記一般式(I)で表される化合物が、電子吸引性は、電子の供与性は、電子系を有していると共に、電子子系を有していると共に、素原子を行せると、ないのではりを調整することができるのかさばりを調整することがであることがである。 前記一般式(I)で表される化合物を少なくとも分極が生ずる際の電子移動が速やかに起こり、非線形光学材料は、光などの形場により分極が生ずる際の電子移動が速やかに起こり、非線形光学定数βが大きく、顕著な非線形光学効果を示す。

また、第2の発明の非線形光学素子によれば、 上記第1の発明の非線形光学材料を用いているため、2次の非線形光学素子が得られ、光強度の弱 いレーザ光でも高強度の第 2 高調液を分離でき、また少ない電圧変化でも電気光学効果を効率よく 発現できるという特有の効果を奏する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、光波長変換素子としての非線形光学 素子の一実施例を示す概略図、

第2図および第3図は、それぞれ光液長変換紫子としての非線形光学素子の他の実施例を示す概略図、

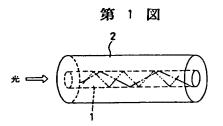
第4図は、位相変調素子としての非線形光学素子の一実施例を示す概略図である。

- (1) … … コア、(2) … … クラッド、
- (21)(31)(41)… 光 導 波 部、
- (22)(32)(42)… 基板、
- (33)…トップ層、(43)…電極。

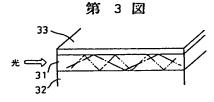
特許出願人 住友電気工業株式会社 代理人 弁理士 43 井 弘 勝 (ほか1名)



符号	- 4	8	科	ŗ.
(1)	כ			7
(2)	2	ラ	7	۴
(21) (31)	光	钳	皮	部
(22) (32)	뀼			板
(33)	۲	~	ナ	匘

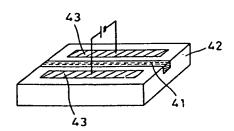


第 2 図



١	符 号	名	称
	(41)	光湖	彼部
ļ	(42)	挺	板
1	(43)	電	極





第1頁の続き

⑩発 明 者 安 田 則 彦 大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株 式会社大阪製作所内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.